

## HZU-G シリ - ズ

シリコンプレ - ナ形ツェナ - ダイオ - ド  
サ - ジ吸収用

RJJ03G0563-0400

Rev.4.00

2006.06.08

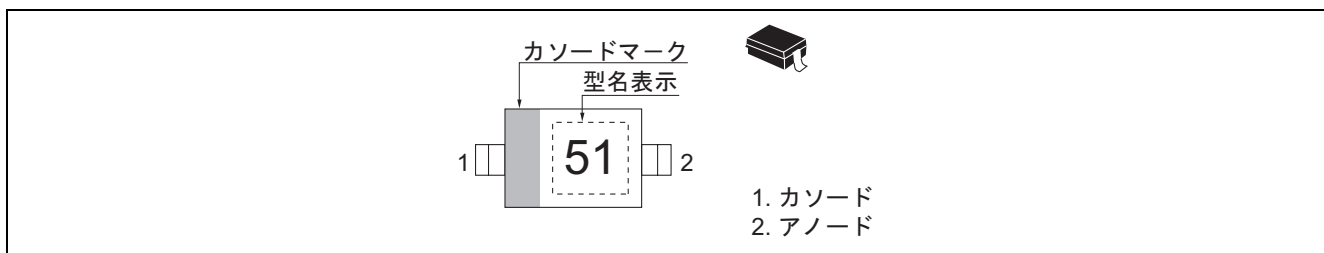
### 特長

- IEC1000-4-2 規格に適合したサージ吸収用ツェナ - ダイオ - ドです。
- 超小型レジソ外形のため小型であり面装着に対応でき又、小型設計及び高密度実装が可能です。

### 型名表示

型名	レーザーマーク	パッケージ名称	パッケージコード
HZU-G シリ - ズ	型名表示表参照	URP	PTSP0002ZA-A

### ピン配置



絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	定格値	単位
許容損失	Pd *	200	mW
接合部温度	Tj	150	°C
保存温度	Tstg	-55 ~ +150	°C

【注】 図 2 参照

電気的特性

(Ta = 25°C)

型名	ツェナ - 電圧			逆電流		動作抵抗		静電破壊電圧
	V <sub>Z</sub> (V) * <sup>1</sup>		測定条件	I <sub>R</sub> (μA)	測定条件	r <sub>d</sub> (Ω)	測定条件	(kV) * <sup>2</sup>
	Min	Max	I <sub>Z</sub> (mA)	Max	V <sub>R</sub> (V)	Max	I <sub>Z</sub> (mA)	Min
HZU5.1G	4.84	5.37	5	5	1.5	130	5	30
HZU5.6G	5.31	5.92	5	5	2.5	80	5	30
HZU6.2G	5.86	6.53	5	2	3.0	50	5	30
HZU6.8G	6.47	7.14	5	2	3.5	30	5	30
HZU7.5G	7.06	7.84	5	2	4.0	30	5	30
HZU8.2G	7.76	8.64	5	2	5.0	30	5	30
HZU9.1G	8.56	9.55	5	2	6.0	30	5	30
HZU10G	9.45	10.55	5	2	7.0	30	5	30
HZU12G	11.42	12.60	5	2	9.0	35	5	30
HZU13G	12.47	13.96	5	2	10.0	35	5	30

- 【注】 1. V<sub>Z</sub>は、パルス 40ms の値  
 2. C = 150pF, R = 330Ω, 順逆各 10 回印加  
 故障判定基準：IR 規格を使用

型名表示表

型名	マ - ク文字
HZU5.1G	51
HZU5.6G	56
HZU6.2G	62
HZU6.8G	68
HZU7.5G	75
HZU8.2G	82
HZU9.1G	91
HZU10G	10
HZU12G	12
HZU13G	13

主特性

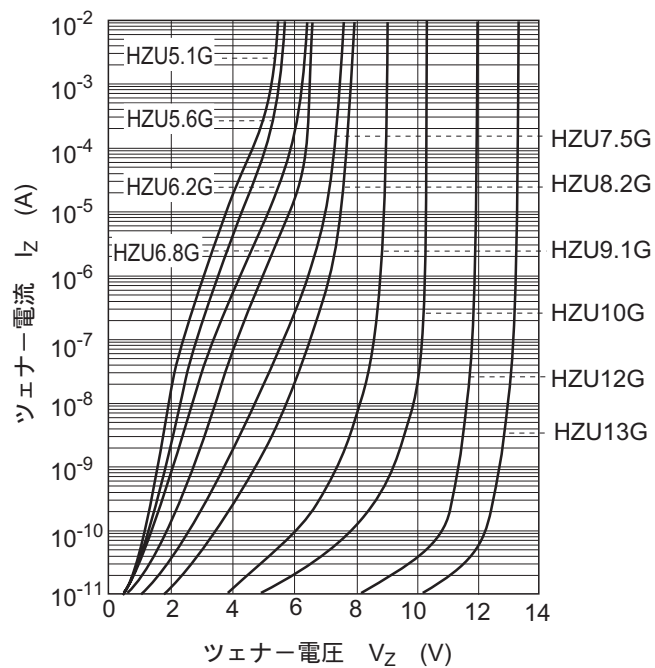


図1. ツェナー特性

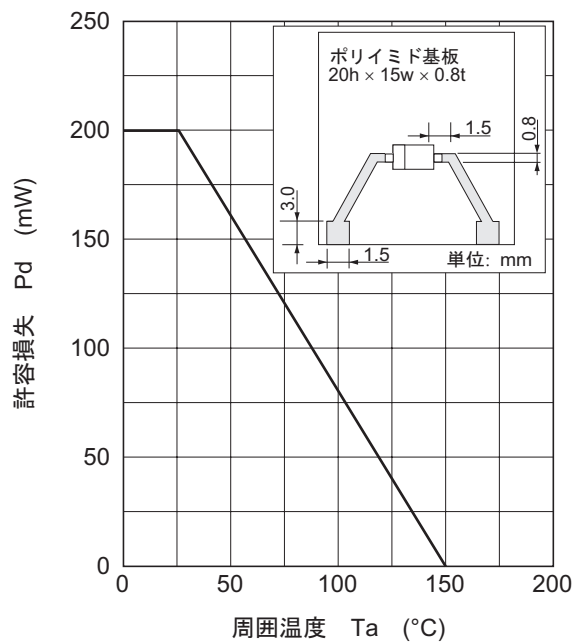


図2. 許容損失 対 周囲温度特性

外形寸法図

